

Фамилия, имя, отчество	Лагов Петр Борисович
Должность, ученая степень, ученое звание	Профессор, д.т.н.
Электронная почта	lagov.pb@misis.ru
Рабочий телефон	+7 499 237-21-29
Трудовая деятельность	Научная и педагогическая 1995–1998 аспирант каф. ППЭ и ФПП 1998-2000 научный сотрудник каф. ППЭ и ФПП 2000-2020 доцент каф. ППЭ и ФПП 2021- н.вр. профессор каф. ППЭ и ФПП (09.12.2021)
Образование	1995 Инженер электронной техники «Микроэлектроника и полупроводниковые приборы», МИСиС, ПМП, 1999 к.т.н. 01.04.10 Физика полупроводников и диэлектриков, 2005 Доцент по каф. ППЭ и ФПП 2018 д.т.н. 05.27.01 Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах
Основные результаты деятельности	1. Золотая медаль XVII Международный салон изобретений и инноваций «Архимед-2014» 2014 за изобретение «Всесезонная гибридная энергетическая вертикальная установка». 2. Бронзовая медаль IENA-2014 66-я Международная выставка «Идеи–Изобретения–Новые Продукты» Германия, г. Нюрнберг. "Всесезонная гибридная энергетическая вертикальная установка" 3. Специальная награда "Зеленый Оскар", 4 Всемирный конкурс "зеленых" изобретений, Международная федерация ассоциаций изобретателей (Президент - Андрас Ведрес). 2014. «Всесезонная гибридная энергетическая вертикальная установка» 4. Почетная грамота, программа "СТАРТ 05" Фонд содействию развитию малых форм предприятий в научно технической сфере. 2005. Разработка фоточувствительных Би-МОП фотодиодных матриц на основе функционально- интегрированных структур. 5. "100 Лучших изобретений России-2015" Федеральная служба по интеллектуальной собственности. 2015. за разработку "Всесезонная гибридная энергетическая вертикальная установка" 6. Серебрянная медаль, Сеульская международная выставка изобретений, Ассоциация продвижения изобретений в Корее. 2016. "Всесезонная гибридная энергетическая вертикальная установка"
Значимые проекты, гранты	ФЦП ИР, "Разработка высокочастотного (10-20 кГц) силового кремниевого диода для роботизированной резистивной сварки", 2015-2016, руководитель. http://fcpir.ru/participation_in_program/contracts/14.584.21.0016/
Значимые публикации	1) A.Y.Polyakov, I.Shchemerov, A.Vasilev, A. Kochkova, N.Smirnov, A.Chernykh, E. Yakimov, P.Lagov et al. 1 GeV Proton Damage in β -Ga ₂ O ₃ . Journal of Applied Physics (2021 в печати) CiteScore=4.4 (2020) Q1 (75%); IF=2,546; Q2 SJR 2020= 0,699 2) A.Y.Polyakov, N.Smirnov, I.Shchemerov, A.Vasilev, A. Kochkova, A.Chernykh, P.Lagov et al. Crystal orientation dependence of deep level spectra in proton irradiated bulk β - Ga ₂ O ₃ . Journal of Applied Physics 130, 035701 (2021); [doi:10.1063/5.0058555] CiteScore=4.4 (2020) Q1 (75%); IF=2,546; Q2 SJR 2020 = 0,699 3) A.Y.Polyakov, C.Haller, R.Butte, N.Smirnov, L.Alexanyan, A.Shikoh, I.Shchemerov, S.Chernykh, P.Lagov et al. Effects of 5 MeV Electron Irradiation on Deep Traps and Electroluminescence from Near-UV InGa _N /Ga _N Single Quantum Well Light-Emitting Diodes With and Without InAl _N Superlattice Underlayer. Journal of Physics D: Applied Physics 53(44), 445111 (2020) [doi:

	10.1088/1361-6463/aba6b7] CiteScore=5.3 (2019) Q1 (84%); IF=3,169, Q1 SJR 2019 = 0,9 4) A Polyakov; C. Haller; R. Butte; N Smirnov; L Alexanyan; A Kochkova; S Shikoh; I Shchemerov; A Chernykh; P Lagov et al. Deep Trap Studies in InGaN/GaN Single Quantum Well Structures Grown With and Without InGaN Underlayers. Journal of Alloys and Compounds Vol. 845, 156269 (2020) CiteScore=7.6 (2019) Q1 (93%); IF=4,65; Q1 SJR 2019 = 1,06 [doi: 10.1016/j.jallcom.2020.156269] 5) A.Y.Polyakov, N.B.Smirnov, I.V.Shchemerov, A.A.Vasilev, E.B.Yakimov, A.V.Chernykh, A.I.Kochkova, P.B.Lagov et al. Pulsed fast reactor neutron irradiation effects in Si doped n-type β-Ga₂O₃. Journal of Physics D: Applied Physics 53(27),274001 (2020) [doi: 10.1088/1361-6463/ab83c4] CiteScore=5.3 (2019) Q1 (84%); IF=3,169; Q1 SJR 2019 = 0,9 6) A.Y.Polyakov, C. Haller, N.B. Smirnov, A.S. Shiko, I.V. Shchemerov, S.V.Chernykh, L.A.Alexanyan, P.B.Lagov et al. Effects of InAlN underlayer on deep traps detected in near-UV InGaN/GaN single quantum well light-emitting diodes. Journal of Applied Physics 126, 115708 (2019); [doi: 10.1063/1.5122314] CiteScore=4.2 (2019) Q1 (77%); IF=2,286; Q2 SJR 2019 = 0,73 7) A.Y.Polyakov, N.B.Smirnov, I.V. Shchemerov, S.J.Pearton, F.Ren, A.V. Chernykh, P. B. Lagov, T.V. Kulevoy. Hole traps and persistent photocapacitance in proton irradiated β-Ga₂O₃ films doped with Si. APL Materials 6, 096102 (2018); [doi: 10.1063/1.5042646] CiteScore=6.6 (2019) Q1 (94%); IF=3,819; Q1 SJR 2018 = 1,53 8) A.Y.Polyakov, N.B.Smirnov, I.V.Shchemerov, E.B.Yakimov, S.J.Pearton, C.Fares, J.Yang, F.Ren, J.Kim, P.B.Lagov, V.S. Stolbunov, A.Kochkova. Defects responsible for charge carrier removal and correlation with deep level introduction in irradiated β-Ga₂O₃ Applied Physics Letters 113(9),092102 (2018). [doi: 10.1063/1.5049130] CiteScore=7.0 (2019) Q1 (91%); IF=3,597; Q1 SJR 2018 = 1,33 9) Polyakov A.Y., Shmidt N.M., Smirnov N.B., Shchemerov I.V., Shabunina E.I., Tal'nishnih N.A., Lagov P.B., et al. Defect States Induced in GaN-Based Green Light Emitting Diodes by Electron Irradiation. ECS Journal of Solid State Science and Technology, 7 (6) P323-P328 (2018). [DOI: 10.1149/2.0211806jss] CiteScore=3.6 (2019) Q2 (66%); IF=2,142; Q2 SJR 2018 = 0,562 10) Lee I.-H., Polyakov A.Y., Smirnov N.B., Shchemerov I.V., Lagov P.B., et al. Point defects controlling non-radiative recombination in GaN blue light emitting diodes: Insights from radiation damage experiments. Journal of Applied Physics 122, 115704 (2017); [DOI: 10.1063/1.5000956] CiteScore=4.2 (2019) Q1 (77%) IF=2,286 Q2 SJR 2017 = 0,739
Индекс Хирша по Scopus Количество статей по Scopus На усмотрение: SPIN РИНЦ ORCID ResearcherID Scopus AuthorID	8614-9639 0000-0002-6987-7877 D-4899-2014 569102707000
Научное руководство /Преподавание	Читаемые дисциплины «Радиационно-технологические процессы в электронике» Руководство аспирантами, магистрами